

Transistor Mosfet IRFP640 200V ,18A 125 W

Codigo: 113054



Descripción

El transistor de efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET (en inglés Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) es un transistor utilizado para amplificar o conmutar señales electrónicas. Es el transistor más utilizado en la industria microelectrónica, ya sea en circuitos analógicos o digitales. IRFP640 es un mosfet de potencia que ofrece al diseñador la mejor combinación de conmutación rápida, el diseño del dispositivo robusto y de baja resistencia.

- Valor dinámico dv / dt

- Evaluación avalancha repetitiva
- Conmutación rápida
- Facilidad de paralelismo
- Requisitos de unidad sencilla

Aplicaciones: Administración de potencia

- Polaridad de transistor: Canal N

- Voltaje de drenaje a fuente VDS: 200 V
- Voltaje de puerta a fuente VGS: ± 20 V
- Corriente continua de drenaje ID: 18 A
- Corriente de drenaje pulsada IDP: 72 A
- Disipación de potencia máxima PD: 125 W
- Resistencia de activación $R_{ds(on)}$: 0.18 ohms
- Temperatura de operación mínima: -55 °C
- Temperatura de operación máxima: 150 °C
- Encapsulado: TO-220
- Número de pines: 3